

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公開番号】特開2000-356680(P2000-356680A)
【公開日】平成12年12月26日(2000.12.26)
【出願番号】特願平11-165353
【国際特許分類第7版】
G 0 1 T 1/24
【F I】
G 0 1 T 1/24

【手続補正書】
【提出日】平成17年11月4日(2005.11.4)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

放射線の照射により電荷を生成する半導体結晶と、前記結晶の第1の面および第2の面にそれぞれ設けられた電荷収集電極と、これら電極間にバイアス電圧を印加する手段と、前記電荷収集電極からの出力信号を電圧に変換する電荷増幅器とを備えた半導体放射線検出装置において、

前記電荷増幅器は、前記電荷収集電極からの出力信号のうち所定の閾値以下の信号を遮断する手段を備えたことを特徴とする半導体放射線検出装置。

【請求項2】

前記半導体結晶の温度を検出する手段と、前記温度検出手段で検出した温度に基づき前記遮断する手段の閾値を変更する手段とを備えたことを特徴とする請求項1記載の半導体放射線検出装置。

【請求項3】

前記所定の閾値は、リーク電流に起因する電子雑音のレベルであることを特徴とする請求項1記載の半導体放射線検出装置。